

Содержание

● Электронные свойства полупроводников

Рагимов С.С., Багиев В.Э., Алиева А.И., Саддинова А.А.

О ширине запрещенной зоны AgSbSe_2 291

Астров Ю.А., Порцель Л.М., Шуман В.Б., Лодыгин А.Н., Абросимов Н.В., Павлов С.Г., Hübers H.-W.

Оптические сечения поглощения и силы осцилляторов двойного донора магния в кремнии 299

● Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Ушаков В.В., Аминев Д.Ф., Кривобок В.С.

Внутрицентровые излучательные переходы на примесных центрах железа в селениде цинка 304

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Поддубный А.Н.

Направленные поверхностные акустические волны в нецентросимметричных решетках 308

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Кочман И.В., Михайлова М.П., Вейнгер А.И., Парфеньев Р.В.

Магнитофонные осцилляции магнитосопротивления в квантовой яме InAs/GaSb с инвертированным зонным спектром 313

Жуков Н.Д., Гавриков М.В., Кабанов В.Ф., Ягудин И.Т.

Одноэлектронный эмиссионно-инжекционный транспорт в микроструктуре с коллоидными квантовыми точками узкозонных полупроводников 319

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Давыдов С.Ю., Посредник О.В.

Адсорбция атомов II и VI групп на поли типах карбида кремния 326

Сидоров Г.Ю., Сидоров Ю.Г., Шве́ц В.А., Варавин В.С.

Образование акцепторных центров в CdHgTe под воздействием воды и термообработок 331

● Физика полупроводниковых приборов

Кузаний А.А.

Полупроводниковый сенсор термоэлектрического однофотонного детектора для регистрации излучения ближнего ИК диапазона 336

Шашкин И.С., Лешко А.Ю., Шамахов В.В., Воронкова Н.В., Капитонов В.А., Бахвалов К.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Копьев П.С.

Мощные непрерывные лазеры $\text{InGaAs}/\text{AlGaAs}$ (1070 нм) с расширенным латеральным волноводом мезаполосковой конструкции 344

Иванов П.А., Лебедева Н.М., Ильинская Н.Д., Самсонова Т.П., Коньков О.И.

Высоковольтные лавинные 4H-SiC диоды с прямой фаской 349

Obi U.C., Sanni D.M., Bello A.

Effect of Absorber Layer Thickness on the Performance of Bismuth-Based Perovskite Solar Cells 354

Sanjay, Prasad B., Vohra A.

Performance Evaluation of Inversion Mode and Junctionless Dual-Material Double-Surrounding Gate Si Nanotube MOSFET for 5-nm Gate Length 355

● Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Бессолов В.Н., Коненкова Е.В., Родин С.Н., Кибаков Д.С., Смирнов В.К.

Образование полуполярных III-нитридных слоев на поверхности $\text{Si}(100)$, структурированной с помощью самоформирующейся наномаски 356

Кудряшов Д.А., Максимова А.А., Вячеслава Е.А., Уваров А.В., Морозов И.А., Баранов А.И., Монастыренко А.О., Гудовских А.С.

Исследование влияния особенностей конструкции установки магнетронного распыления на электрические и оптические свойства пленок оксида индия-олова 360

Марков Л.К., Павлюченко А.С., Смирнова И.П., Меш М.В., Колоколов Д.С.

Применение метода атомно-слоевого осаждения для получения наноструктурированных покрытий $\text{ITO}/\text{Al}_2\text{O}_3$. . . 365

Ложкина Д.А., Астрова Е.В., Соколов Р.В., Кириленко Д.А., Левин А.А., Парфеньева А.В., Улин В.П.

Формирование кремниевых нанокластеров при диспропорционировании монооксида кремния 373

Rabehi A., Akkal B., Amrani M., Tizi S., Benamara Z., Helal H., Douara A., Nail B., Ziane A.

Current–Voltage, Capacitance–Voltage–Temperature, and DLTS Studies of $\text{Ni}/6\text{H-SiC}$ Schottky Diode 388